ショートノート -

接触電流に対する体内誘導量評価における準静的 FDTD 法の有効性の検討

服部 潤哉[†] 平田 晃正^{†a)} (正員). Effectiveness of Quasi-Static FDTD Method for Dosimetry in Human due to Contact Current Junya HATTORI[†], Nonmember and Akimasa HIRATA^{†a)}, Member

[†]名古屋工業大学大学院工学研究科,名古屋市 Graduate School of Engineering, Nagoya Institute of Technology, Nagoya-shi, 466-8555 Japan

a) E-mail: ahirata@nitech.ac.jp

あらまし 接触電流に伴う体内誘導電界の解析に準 静的 FDTD 法を適用した場合の有効性について検討 する.誤差要因として,変位電流,モデル化の際の階 段近似,モデルの不均質性を考え,円柱モデルを用い て各要因に伴う誤差を明らかにした.

キーワード 接触電流,準静的 FDTD 法,体内誘 導電界評価,ドシメトリ

1. まえがき

低周波から中間周波数帯における接触電流が人体に 流出入する場合には、末梢神経系へ刺激を与える可能 性がある.ここで、接触電流とは、電磁界ばく露によ り異なる電位ポテンシャルをもった金属構造物と人体 が接触するときに生じるものである.近年では、IH 調理器の普及、あるいは無線電力伝送の実用化に向け た動きもあり、接触電流により体内に誘導される電磁 界の評価に関心が高まっている.ICNIRP ガイドライ ン[1] や IEEE/ICES 規格[2],[3] では、接触電流の参 考レベルと体内誘導電界の基本制限を設けている.し かしながら、体内誘導量の実測は困難であるため、計 算機を用いた数値解析により、ガイドラインにおける 参考レベルと基本制限の関係の確認が行われるように なった[4],[5].

定常的接触電流に伴う体内誘導電界の数値解析には SPFD 法 [4], [5] や準静的 FDTD 法 [6] の適用例が報 告されている.特に,準静的 FDTD 法は,複雑な波 源に適用できることから,今後,より現実的な問題へ の適用が期待される.しかしながら,均質な人体モデ ルを用い,変位電流を無視したことによる誤差の検討 は行ったものの [6],誤差要因の詳細な定量評価は行わ れていない.

本論文では、準静的 FDTD 法を接触電流に対する 人体ドシメトリに適用した場合の有効性評価を目的と し,損失性誘電体からなる円柱モデルを対象として, 変位電流,モデル化の際の階段近似,モデルの不均質 性に伴う数値誤差を検討する.また,検討を行う周波 数は総務省電波防護指針[7]で管理指針が設けられて いる 10 kHz から 100 MHz までとした.

2. 解析モデルと方法

2.1 解析モデル

解析には、人体の胴体部を模擬した直径 0.25 mの 円柱を用いた.円柱の高さは後述する理論解の導出で は無限長とするため、また、計算機メモリの限界も考 慮し2mとした.以降の検討では、均質及び3層か らなる円柱モデルを用いる. モデルの構成組織は、均 質な場合は筋肉,不均質な場合には外側から皮膚,脂 肪,筋肉の3層とした.なお,皮膚,脂肪の厚さはそ れぞれ5mm, 10mmとした. モデルの解像度として は、10mm、5mm、2.5mmの3種類とした. 電流の 向きを一様とするため上端と下端は金属円柱平板とし た. 人体組織の電気定数は、4-Cole-Cole モデルで与 えられるデータベース [8] に基づき,周波数ごとに異 なる値を与えた.人体組織における導電率と比誘電率 を表1に示す。なお、準静近似では、変位電流が無視 できることが前提となるため、準静的 FDTD 法にお ける比誘電率は全ての組織で1とした.

2.2 解析領域

解析条件を図1に示す.円柱モデルの上端と下端を 金属線により解析領域の外側にある吸収境界までつな ぎ,接地した.吸収境界には12層のPMLを用い,吸 収境界とモデル表面の間には50セルの間隔を設けた. 上端側の金属線にはーセルのギャップを設け,電圧源 を挿入した.周波数は,10kHzから100MHzまでと した.また,波源の電圧 V(t) は経過時間 t で場合分

表 1 人体組織の導電率と比誘電率

Table 1 Conductivity and relative permittivity of human tissues.

		10kHz	1MHz	100MHz
Muscle	σ [S/m]	0.34	0.50	0.71
	\mathcal{E}_r	25909	1836	66
Fat	σ [S/m]	0.024	0.025	0.036
	\mathcal{E}_r	1085	27	6.1
Skin	σ [S/m]	2.0×10^{-4}	0.013	0.49
	E _r	1133	991	73

84 電子情報通信学会論文誌 C Vol. J95-C No. 4 pp. 84-87 ⓒ一般社団法人電子情報通信学会 2012

ショートノート





けし,式(1)に示す立上りの緩やかなステップ関数として励振した[6].

$$V(t) = \begin{cases} V_0 \frac{2}{\tau^2} t^2 & 0 < t \le \frac{\tau}{2} \\ V_0 - V_0 \frac{2}{\tau^2} (t - \tau)^2 & \frac{\tau}{2} < t \le \tau \\ V_0 & \tau < t \end{cases}$$
(1)

ここで、 V_0 は模擬する正弦波の波高値、 τ は電圧が V_0 に達するまでの時間であり、高周波成分が生じないように設定した.この入力波形に対し、モデル内の誘導量が時間的に一定となった時点で解析を終了するものとする.本研究で示す計算例では、総計算回数 6000 ステップに対して、 τ は 500 ステップとした.

3. 理論解の導出方法

損失性誘電体から構成される無限長の円柱に電流 が流れるときの電磁界分布の一般解は、円筒座標系 (r, φ, z) を用い、電流の方向がz方向のみであり、か つ $z \ge \varphi$ に依存しないと仮定して以下の式で与えるこ とができる [9].

$$E_z(r) = AJ_0(kr) + BN_0(kr)$$
 (2)

$$H_{\varphi}(r) = -\frac{Ak}{i\omega\mu}J_1(kr) - \frac{Bk}{i\omega\mu}N_1(kr)$$
(3)

$$k^2 = -i\omega\mu\sigma^* \tag{4}$$

$$\sigma^* = \sigma + i\omega\varepsilon \tag{5}$$

$$J_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!(n+m)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2m}$$
(6)

$$N_n(x) = rac{2}{\pi} J_n(x) \left\{ \gamma + \log\left(rac{x}{2}
ight)
ight\}$$

$$-\frac{1}{\pi} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^{l}}{l!(n+l)!} \left\{ \sum_{m=1}^{l} \frac{1}{m} + \sum_{m=1}^{l+n} \frac{1}{m} \right\} \left(\frac{x}{2} \right)^{2l+n} \\ -\frac{1}{\pi} \sum_{l=0}^{n-1} \frac{(n-l-1)!}{l!} \left(\frac{x}{2} \right)^{2l-n}$$
(7)

$$\gamma = \lim_{l \to \infty} \left\{ \sum_{m=1}^{l} \frac{1}{m} - \log(l) \right\}$$
(8)

であり、rは円柱の中心軸からの距離、A 及びBは未 知定数である.なお、 $N_0(kr)$ はr = 0 で発散するた め均質な円柱ではB = 0とならなければいけない.こ こで、円柱の半径をa、円柱を流れる電流強度をIと して、磁界を円柱の外縁上で線積分して、

$$I = \oint H_{\varphi}(a)ad\varphi$$

$$I = -2\pi a \frac{Ak}{i\omega\mu} J_1(ka) \qquad (9)$$

$$A = \frac{k}{2\pi a\sigma} \frac{I}{J_1(ka)}$$

が得られる.

一方,3層の円柱については,kと未知定数は組織 ごとに異なる値をもつ。未知定数は、層間の電磁界の 境界条件を満たすことにより,均質な場合と同様に求 めることができる。また,σ*を近似的にσとみなせ るとすることにより,変位電流を無視した場合の電界 分布の理論解が求まる。

4. 結果と考察

準静近似の適用限界,つまり変位電流を無視した場 合に生じる理論誤差及び準静的 FDTD 法を適用した 場合に生じる数値誤差を以下の式で定義した.なお, 準静的 FDTD 法では,電流の方向が一様となる円柱 の中点の *x-y* 断面の電界を電流強度が理論解と等しく なるよう規格化して用いることとする.

$$\boldsymbol{Error}(\boldsymbol{r}) = \frac{|\boldsymbol{E}_{qs}(\boldsymbol{r}) - \boldsymbol{E}_{ana}(\boldsymbol{r})|}{E_{\max}} \times 100 \quad [\%]$$
(10)

ここで, $E_{qs}(\mathbf{r})$ は変位電流を無視した場合の電界の z 方向成分の理論解または準静的 FDTD 法より求め た電界のz 方向成分であり, $E_{ana}(\mathbf{r})$ は変位電流を考 慮した電界の理論解である. E_{max} は $E_{ana}(\mathbf{r})$ の最大 値とし, 誤差を規格化した.

まず,解像度5mmの均質な円柱の変位電流を無視したことによる理論誤差と準静的FDTD法の数値誤



図 2 変位電流を無視したことによる理論誤差と準静的
 FDTD 法の数値誤差(解像度 5 mm)

Fig. 2 Theoretical error caused by neglecting displacement current and computational error with quasi-static FDTD (5 mm resolution).



Fig. 3 Maximum error caused by staircase approximation.

差の平均値と最大値を図2に示す.図2より,変位電 流を無視したことによる理論誤差は,周波数が高くな るに従い,振動しながら大きくなることが分かる.準 静的 FDTD 法を用いて解析した場合の数値誤差は, おおよそ 50 MHz 以下の周波数においては,ほぼ一定 である.一方,50 MHz 以上の周波数においては,周 波数が高いほど,誤差が大きいことが分かる.ここで, 準静的 FDTD 法の数値誤差は,変位電流を無視した ことによる理論誤差とモデル化の階段近似による数値 誤差の複合的なものである.

次に、モデルの階段近似による数値誤差について検 討する.均質な円柱モデルの解像度を10mm、5mm、 2.5mmと変化させた場合の準静的FDTD法の数値誤 差の最大値を図3に示す.図3より、おおよそ50MHz





Fig. 4 Distributions of error with quasi-static FDTD method at 10 MHz (5-mm resolution): (a) homogeneous model and (b) three-layer model.

以下の周波数では,解像度が高いほど誤差が小さいこ とが分かる.これは解像度が高いほどモデル化の際の 階段近似による数値誤差が小さいためである.また, 50 MHz 以上の周波数においては解像度による差異は ほとんど見られない.これは変位電流を無視したこと による理論誤差がモデル化に伴う階段近似による数値 誤差よりも十分大きいためであると考えられる.

更に、モデルの不均質性を検討するために、3層モ デルを用いた場合に生じる数値誤差について検討する. モデルが均質な場合と不均質な場合の10MHzにおけ る準静的 FDTD 法の数値誤差分布を図4に示す.図4 より、いずれの場合も外縁付近で誤差が大きいことが 分かる.これは、準静近似を適用しない理論解では周 波数が高い場合には表皮効果により,円柱の外縁部の 電流密度が高くなり電界も大きくなるのに対し、準静 的 FDTD 法では高周波成分が含まれないと仮定する ため、事実上表皮効果がなく、電界分布が一様となる ためである.また、均質モデルと比べ、3層モデルに おける誤差が小さいことが分かる. これは式(11)で 定義した誤差の規格化に起因するものであり、3層モ デルにおける電界の最大値が均質モデルに比べ大きい ためであると考えられる. なお,3層モデルにおける 数値誤差の周波数依存性は均質な場合と同様の傾向で あり、また、10 MHz 以外の周波数においても3 層モ デルにおける誤差の方が小さくなった.

外部電磁界ばく露による体内誘導量の数値解析において、電流ベクトルが急激に変化する場合には、階段状の部分においてボクセルに特異点が生じ、誤差が数10%にのぼることが報告されている[10].しかしながら、接触電流に対しては、円柱が不均質な場合においてすら、特異点による影響は顕著ではなかった.これ

ショートノート

は電流の向きが z 方向のみであり, 階段状の部分に 沿った電流が生じないためであると考えられる.

5. む す び

中間周波数帯における接触電流に伴う体内誘導電界 の解析に準静的 FDTD 法を適用した場合の有効性を 検討するために,損失性誘電体から構成される円柱を 対象とした検討を行った.その結果,50 MHz 以下の 電流では,モデルの階段近似に伴う数値誤差が変位電 流を無視したことによる理論誤差よりも大きく,解像 度 2.5 mm の均質な円柱で 2~3%であった.また,外 部電磁界ばく露で報告されていた離散化に伴う特異的 な数値誤差は,複数層モデルを用いた場合でも顕著で はなかった.

今後の課題として,準静的 FDTD 法を用いた人体 ドシメトリが挙げられる.

文 献

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, "ICNIRP Statement-Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (1 Hz to 100 kHz)," Health Phys., vol.99, no.6, pp.818-836, 2010.
- [2] IEEE Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Electromagnetic Fields, 0-3 kHz, IEEE Std. C95.6-2002.

- [3] IEEE Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields, 3 kHz to 300 GHz, IEEE Std. C95.1-2005.
- [4] T.W. Dawson, K. Caputa, M.A. Stuchly, and R. Kavet, "Electric fields in the human body resulting from 60-Hz contact currents," IEEE Trans. Biomed. Eng., vol.48, no.9, pp.1020-1026, Sept. 2001.
- [5] 平尾賢司,太良尾浩生,林 則行,伊坂勝生,"低周波接 触電流による体内電流密度分布簿基礎検討,"信学技報, EMCJ2008-16,2008.
- [6] A. Hirata, Y. Takano, and T. Nagai, "Quasi-Static FDTD method for dosimetry in human due to contact current," IEICE Trans. Electron., vol.E93-C, no.1, pp.60-65, Jan. 2010.
- [7] 郵政省電気通信技術審議会答申,"諮問第 38 号「電波利用における人体の防護指針」,"1990.
- C. Gabriel, "Compilation of the dielectric properties of body tissues at RF and microwave frequencies," Brooks Air Force Technical Report AL/OE-TR-1996-0037, 1996.
- [9] 砂川重信,理論電磁気学,pp.181-184,紀伊国屋書店, 東京,1999.
- [10] T.W. Dawson, M. Potter, and M.A. Stuchly, "Evaluation of modeling accuracy of power frequency field interaction with the human body," Comput. Electromag. Soc. J., vol.16, no.2, pp.162-172, 2001.

(平成 23 年 7 月 21 日受付, 9 月 22 日再受付)